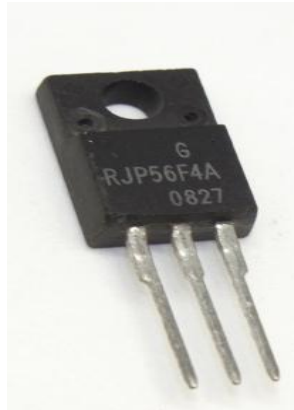


IGBT 430V/200A

Número de parte: RJP56F4



Descripción:

Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT), es un dispositivo semiconductor que generalmente se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia.

El transistor IGBT es adecuado para velocidades de conmutación de hasta 100 KHz (en algunos casos menores de 100KHz). Su conmutación es de alta velocidad.

Encapsulado: TO 220FN.

Energía de disipación: De 3W y máxima disipación de 30W.

Voltaje de la fuente: 4.75V a 5.25V.

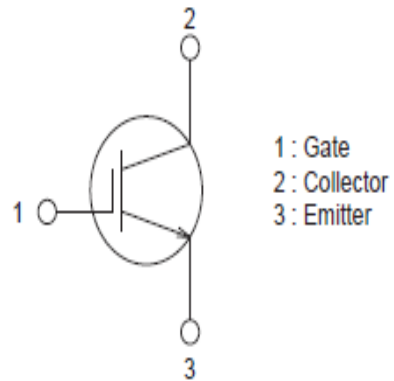
Voltaje de colector-emisor: 430V.

Corriente de colector: 200A.

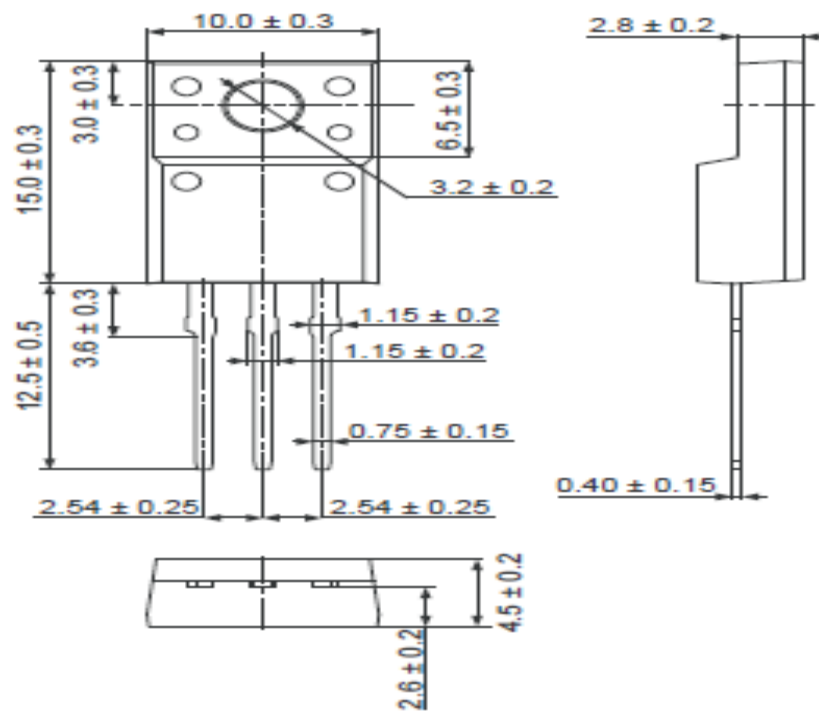
Voltaje de compuerta- emisor: $\pm 33V$.

Temperatura de funcionamiento: $-50^{\circ}C$ a $150^{\circ}C$.

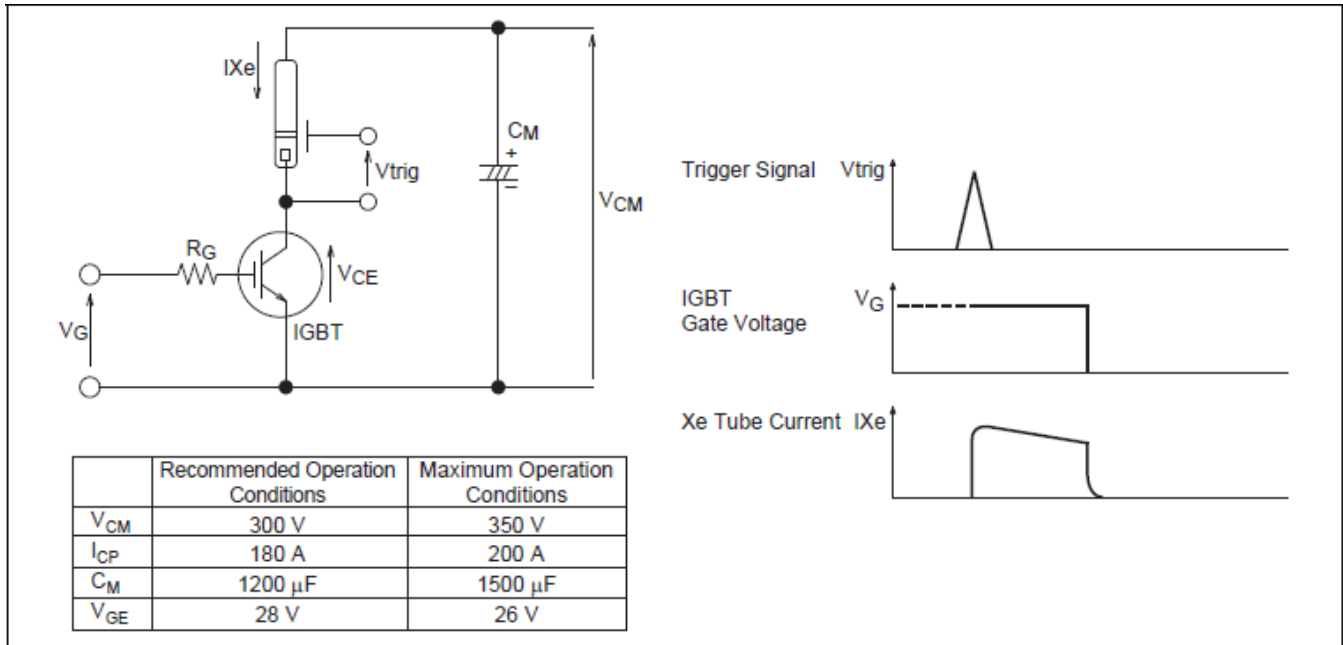
RENESAS Package code: PRSS0003AF-A)
(Package name: TO-220FL)



Dimensiones:



Ejemplo de aplicación:



En este ejemplo hay una aplicación del uso de operación recomendado (columna del lado izquierdo de la tabla) y de las condiciones máximas de operación (columna del lado derecho de la tabla).

Precauciones sobre el uso:

1. El transistor IGBT tiene estructura MOS y su puerta está aislada por óxido de silicio delgada. Asegúrese de manejarlo cuidadosamente para proteger el dispositivo de carga electrostática.
2. El total de horas de funcionamiento aplicadas a puerta-emisor debe estar dentro de 5.000 horas.
3. Frecuencia de conmutación mínima de 50 kHz.

 AG Electrónica S.A. de C.V.	AG Electrónica S.A. de C.V. República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 5130 - 7210		
	Acotación: NA	http://www.agelectronica.com/	Escala NA
Tolerancia: NA	Descripción: IGBT 430V/200A		
Tolerancia: NA	Fecha: 17/06/2015	Número de parte: RJP56F4	